

2025年6月期第2四半期 WEB 決算説明会（2025年2月12日開催）**およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【投資動向・受注高】****1. 上期受注高実績が期首計画を下回った背景は？また、下期に受注が増加する要因は？**

A: 2QにITパネル用OLED（G8.7）の案件を受注したことで、1Qと比較して受注高は増加した。しかし、EV需要の鈍化により、パワーデバイスやEVモーターに搭載される高機能磁石向け製造装置の投資が減速し、バッテリー関連の投資も遅延傾向にある。これらの投資が期首の想定よりも遅れており、下期にかけても市況の改善を見込むことが難しく、年間受注見込みを見直した。

一方で、先端ロジック・メモリなどの半導体や先端パッケージングの投資が活発化しており、さらにLCD、OLED（G6）パネルの高精細化に向けた設備追加・改造案件が寄与することで、下期にかけて受注は増加すると見込んでいる。また、コンポーネント、マテリアル、カスタマーサポート、その他に分類される表面分析装置やマスクブランクスは堅調に推移しており、安定基盤として貢献していく。

2. 期首計画との差異、3ヶ月前と比較して事業環境など状況に変化は？パワーデバイスの落ち込みは、半導体（ロジック・メモリ）やパッケージングで補うのではなかったのか？

A: パワーデバイスの投資減速は予測していたものの、EV需要の鈍化がより明確になってきた。完全に投資案件がないわけではなく、下期にいくつかの投資を見込んでいたが、顧客の投資計画の延期が具体化し始めたことや、8インチへのシフトの端境期にあることの影響を受け、受注見直しを見直した。

また、一般産業に分類される高機能磁石向け製造装置についても、中国での大型投資を控える動きがあり、見通しを調整した。バッテリーに関しては、下期に受注案件を見込んでいるものの、次世代バッテリーの車載への採用タイミングが遅延しているため、一部の案件は来期にずれ込む見込み。

下期にかけて半導体（ロジック・メモリ）やパッケージングビジネスの増加を見込んでいるが、EV需要鈍化等による影響をオフセットするのが難しい状況となり、期首計画に対して調整が必要となった。

3. 上期受注が前年同期比で下がっているのはなぜか？

A: 前1Qでは、6インチ向けSiCパワーデバイス関連の投資が主力地域の日本と中国で活発化し、バッテリー関連の投資も、各社が少しでも早く量産化・製品化を進めようと、前1Qに集中していた。その結果、当上期の受注は、主にEV関連投資の反動減により、前年同期比で下がっている。

4. 来期以降はどのように見込んでいるのか？受注が落ち込んだことで中計最終年度である来期に与える影響は？

A: 26/6期についてはEV需要の鈍化により、パワーデバイスの弱含みは来期も続く見込み。しかし、半導体や先端パッケージングへの投資は、当期以上に増加することが予想されている。また、バッテリー投資の活発化も見込まれており、コンポーネント、マテリアル、カスタマーサポートなどは堅調に推移する見通しであり、これらのビジネスでパワーデバイスの落ち込みを補う見込み。来期の数値については慎重に見極めているが、市況環境や投資動向のトレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指している中、売上高 3,000 億円、売上総利益率 35%、営業利益率 16%、ROE14%の中計最終目標は変えていない。

5. 生成 AI 関連ビジネスとして、ロジック・メモリの半導体・パッケージングビジネスはどのような見通しなのか？

A: ロジック

5nm および 3nm の高稼働率に伴い、MHM（メタル・ハード・マスク）工程の増産投資が進んでいるほか、DUV 露光向けでも MHM の適用が拡大している。また、MHM の金属材料である TiN を電極材料として適用する動きも見られ、従来から実績のある MHM の適用範囲がさらに広がっている。

今後、2nm 世代への進展に伴い、トランジスタが Fin 構造から Sheet 構造へ移行する中、既に POR（Process of Record）を獲得している拡散工程のための新しいハードマスクの受注拡大が期待されている。また、トランジスタ構造の変化により裏面配線の適用が見込まれており、そこにもビジネス機会があると考えている。ハードマスク用途の増加に加え、セカンドベンダーとしての期待もあり、他の金属工程等の共同開発が進行中であり、さらなる POR 獲得件数の拡大を目指している。

メモリ

生成 AI 関連ビジネスの活発化に伴い、HBM（High Bandwidth Memory）需要の拡大が継続すると見込んでいる。HBM 構造で DRAM をつなぎ合わせる配線層工程が寄与することに加え、HBM を構成する従来の DRAM（DDR5）への投資拡大も期待できる。また、DRAM の微細化が進む中で、ロジックで実績のある TiN MHM（チタンナイトライド・メタル・ハード・マスク）の適用が期待されている。

NAND は在庫調整が進展する中、次世代 NAND 向け投資が開始され、2Q でも受注が集中した。DRAM・NAND ともに他の金属工程等の共同開発が進行中であり、さらなる POR 獲得件数の拡大を目指している。

パッケージング

生成 AI 需要拡大に伴い、先端パッケージング向け投資も活況であり、ファウンダリー向けインターポーザ用デスカム処理装置等で当期 100 億円程度の受注を見込む。次世代先端パッケージング向けスパッタリング装置、デスカム・デスミア処理装置、プラズマダイシング等の開発も進んでおり、積極的に取り組みビジネス拡大を目指す。

6. EV 需要鈍化等による影響として、パワーデバイス・バッテリー・一般産業の投資トレンドはどのようになるのか？

A: パワーデバイス

グリーンエネルギー化や EV 化に伴い、SiC パワーデバイスの需要が中長期的に増加すると見込まれている。これにより、6 インチから 8 インチへのウェハーサイズアップやトレンチ構造化に伴うビジネスチャンスの拡大が期待されている。しかし、現在は EV 市場の成長が鈍化しているため、8 インチ化への投資計画が遅れており、本格的な投資は 2027 年 6 月期以降に進められると予想している。

SiC 6 インチ向けでは、日本市場でスパッタリング装置が 7 割のシェアを確保し、中国市場ではイオン注入装置が 7 割のシェアを確保している。8 インチへのシフトに際しても、高いシェアを維持していく方針。さらに、日本市場ではスパッタリング装置に加え、中国市場で実績のあるイオン注入装置のクロスセルを推進し、中国市場ではイオン注入装置に加え、日本市場で実績のあるスパッタリング装置のクロスセルを推進していく。

SiC パワーデバイスの構造がブレナーからトレンチ構造に移行することで、SiC 化合物に適したエッチング装置の拡販を目指す。また、GaN 化合物のスパッタリング装置を市場に投入しており、将来の需要を取り込んでいきたい。

バッテリー

バッテリーの安全性向上や小型軽量化を目的とした、従来の正極集電体であるアルミ箔からアルミの両面蒸着膜への置き換え投資のため中長期な成長予測自体は変えていない。今後、車載への採用が進展するにつれて、投資は本格化すると見ている。また、アルミ両面蒸着膜のフィルム幅を広げることで生産性をさらに向上させ差別化を図り、市場シェアを確保する方針。さらに、銅の両面蒸着膜向け装置を開発し、負極集電体の置き換えを進めることでビジネスを拡大していく。

将来の取り組みとして、リチウムを用いた次世代電池負極の開発を進めることで、さらなる成長を目指す。

一般産業

EV モーターに搭載される高機能磁石製造装置について、各磁石メーカーが収益改善を図るため、大型投資を控える傾向にある。一方で、中国リスクを背景に、中国以外の地域での投資案件が増加している動きがあり、これらの案件に積極的に取り組むことで成長を図っていく。

7. OLED などの FPD 関連ビジネスの投資動向について教えてほしい

A: 2Q には 100 億円程度の大口案件を受注するなど、タブレット・PC 向け IT パネル用 OLED の投資が本格化している。従来のスマホ用 G6 パネルよりも大きい G8.7 パネルサイズに対応し、パーティクルの少ない半導体仕様の枚葉型スパッタリング装置を導入している。また、タッチセンサー用に透明電極をスパッタリングする際、温度に敏感な OLED プロセスで低温成膜による高速成膜を実現し、高い生産性を達成している。

さらに OLED 蒸着装置向けクライオポンプは、競合と比べて振動が少なく、蒸着マスクのアライメントへの影響を最小限に抑えることが可能である。また、高い排気性能や省エネといった強みを持っている。このため、OLED 蒸着装置向けではデファクトスタンダードとなっている。これにより、OLED 蒸着ビジネス領域を全てカバーし、ビジネスチャンスをしっかりと掴んでいく。

加えて、下期にかけて中国の補助金の適用が始まったこともあり、LCD、OLED (G6) の高精細化に向けた投資が寄与することを見込んでいる。

8. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？

A: 現状、中国における半導体関連ビジネスのウェイトはそれほど大きくないが、MHM の DUV 露光への適用拡大等に伴い、引き合いは徐々に増加している。仮に米国による規制が強化されたとしても、中国の半導体関連ビジネスは計画に大きく織り込んでいないため、影響は限定的と見ている。一方で、パワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリーなどに対する規制強化は認識しておらず、現時点ではビジネスへの影響を感じていない。

【売上高・利益（率）】

9. 上期は売上高・営業利益が前年同期・計画を上回ったが、下期はどう見ているのか？ 受注見直し後の通期業績予想を変更していないが、達成可能なのか？

A: 2Q に一部前倒しで売上が計上されたため、下期の目標売上高は 1,401 億円となった。2Q 末の受注残高は 1,255 億円であり、その 7 割程度が下期の売上高に寄与すると見込んでいる。また、下期売上高には受注高が堅調に推移しているコンポーネント、マテリアル、カスタマーサポートの売上寄与があり、さらに半導体電子、FPD、バッテリーなどの装置リードタイムが前期と比べて短縮しているため、工程進捗が早まっている。このことから、受注見直しを 100 億円見直したとしても、通期売上高予想の 2,750 億円は達成可能と考えている。

10. 売上総利益率 1Q : 31.3%→2Q:32.2 と 0.9pt 改善し、2Q 売上総利益 238 億円と四半期ベースで上場来最高水準となった主な要因は？ 下期は更に良くなるのか？

A: 1Q から 2Q にかけては、主に増収効果により売上総利益率が改善した。引き続き、利益率の高い半導体電子やコンポーネントの売上高構成比が 50%を超えており、利益率のベースは着実に上昇している。下期にかけても、利益率の着実な改善を見込んでいる。

11. 販管費はどのように推移するのか？

A: 販管費は、半導体電子を中心に研究開発投資を継続することに加え、ベースアップなどによる人件費の上昇も織り込んでおり前期より増加する計画であり、販管費率は 20%前後の水準で推移すると見込んでいる。今後も状況に応じて柔軟に販管費（固定費）コントロールを行っていく。

12. 主な機種別のリードタイムを教えてください。

A: 顧客への納期リードタイムという点では、
ロジック・メモリ向けスパッタ装置は、計画的生産対応機種は 3～5 ヶ月、
（フォーキャストの無い新規案件は 10 か月程度要す）
電子デバイス関連で、標準仕様のスパッタ、蒸着、エッチング装置は 5～9 か月、
特型装置は受注してから部品発注を行うため 10 ヶ月以上となるものもある。
パワーデバイス用イオン注入装置は標準仕様で 7 ヶ月程度、特型装置は 10 ヶ月以上をこえるものもある。
バッテリー向け両面蒸着巻取装置は、10～11 ヶ月程度となっている。

13. 上期の半導体電子およびディスプレイ・エネルギーの受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙のとおり。

14. 上期の営業利益率順位は？

A: 別紙のとおり。

15. 25/6 期の設備投資、減価償却費の計画・実績は？

A: 設備投資 年間計画 192 億円 実績 84 億円（進捗率：44%）
うち、研究開発 年間計画 105 億円 実績 43 億円（41%）
研究開発費 年間計画 140 億 実績 69 億円（49%）
減価償却費 年間計画 100 億円 実績 54 億円（54%）

別紙：品目別内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	25/6期 上期
半導体電子 (億円)	378
・メモリ	3割半ば
・ロジック	1割半ば
・電子部品	2割弱
・パワー半導体	1割半ば
・実装	2割弱
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー	254
・LCD	3割弱
・OLED	7割弱
・バッテリー	数%
・その他	数%

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	25/6期 上期
半導体電子 (億円)	477
・メモリ	2割半ば
・ロジック	1割半ば
・電子部品	2割強
・パワー半導体	2割半ば
・実装	1割強
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー	317
・LCD	約3割
・OLED	4割弱
・バッテリー	2割半ば
・その他	1割弱

●営業利益率順位 25/6期 上期

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	一般産業
4	その他
5	ディスプレイ・エネルギー
6	マテリアル

全社平均利益率は

- 3) 一般産業と
- 4) その他との間